

Docket No.: 65326-033

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of : Customer Number: 20277
Masahiro HORIE : Confirmation Number:
Serial No.: : Group Art Unit:
Filed: March 04, 2004 : Examiner:
For: SPECTROSCOPIC ELLIPSOMETER

CLAIM OF PRIORITY AND
TRANSMITTAL OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENT

Mail Stop CPD
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

In accordance with the provisions of 35 U.S.C. 119, Applicant hereby claim the priority of:

Japanese Patent Application No. JP 2003-141796, filed on May 20, 2003.

Japanese Patent Application No. JP 2003-395259, filed on November 26, 2003.

cited in the Declaration of the present application. Certified copies are submitted herewith.

Respectfully submitted,

MCDERMOTT, WILL & EMERY


Stephen A. Becker
Registration No. 26,527

600 13th Street, N.W.
Washington, DC 20005-3096
(202) 756-8000 SAB:gav
Facsimile: (202) 756-8087
Date: March 4, 2004

65326-033
Masahiro HORIE
March 4, 2004

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

McDermott, Will & Emery

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年 5月20日
Date of Application:

出願番号 特願2003-141796
Application Number:

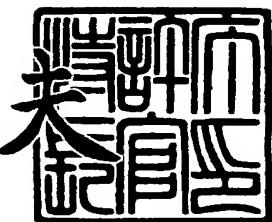
[ST. 10/C] : [JP 2003-141796]

出願人 大日本スクリーン製造株式会社
Applicant(s):

2003年12月11日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康



出証番号 出証特2003-3103177

【書類名】 特許願

【整理番号】 006P0092

【提出日】 平成15年 5月20日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G01N 21/21

【発明者】

【住所又は居所】 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1
番地の1 大日本スクリーン製造株式会社内

【氏名】 堀江 正浩

【特許出願人】

【識別番号】 000207551

【氏名又は名称】 大日本スクリーン製造株式会社

【代理人】

【識別番号】 100110847

【弁理士】

【氏名又は名称】 松阪 正弘

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 136468

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0107099

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 分光エリプソメータ

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 分光エリプソメータであって、

偏光した光を対象物へと導く照明部と、
前記対象物からの前記偏光した光の反射光を受光して前記反射光の波長毎の偏光状態を取得する受光部と、

を備え、

前記照明部が、
光源部と、
前記光源部からの光から前記偏光した光を得る偏光素子であるポーラライザと
、
を有し、

前記光源部から前記対象物に至る光路上において、少なくとも 1 つの反射ミラーが前記光源部と前記ポーラライザとの間のみに配置されることを特徴とする分光エリプソメータ。

【請求項 2】 請求項 1 に記載の分光エリプソメータであって、

前記受光部が、
前記反射光が入射する偏光素子であるアナライザと、
前記アナライザを経由した前記反射光が入射する分光器と、
を有し、

前記照明部または前記受光部が、前記ポーラライザまたは前記アナライザを回転する回転機構を有し、

前記対象物から前記分光器に至る光路上において、少なくとも 1 つの反射ミラーが前記アナライザと前記分光器との間のみに配置されることを特徴とする分光エリプソメータ。

【請求項 3】 請求項 1 または 2 に記載の分光エリプソメータであって、

前記ポーラライザが、シート状の偏光素子であることを特徴とする分光エリプソメータ。

【請求項 4】 請求項 1 ないし 3 のいずれかに記載の分光エリプソメータであって、

前記光源部と前記ポーラライザとの間に複数の反射ミラーが配置されることを特徴とする分光エリプソメータ。

【請求項 5】 請求項 4 に記載の分光エリプソメータであって、

前記複数の反射ミラーが、複数の回転楕円体ミラーを含むことを特徴とする分光エリプソメータ。

【請求項 6】 分光エリプソメータであって、

偏光した光を対象物へと導く照明部と、

前記対象物からの前記偏光した光の反射光を受光して前記反射光の波長毎の偏光状態を取得する受光部と、

を備え、

前記受光部が、

前記反射光が入射する偏光素子であるアナライザと、

前記アナライザを経由した前記反射光が入射する分光器と、
を有し、

前記対象物から前記分光器に至る光路上において、少なくとも 1 つの反射ミラーが前記アナライザと前記分光器との間のみに配置されることを特徴とする分光エリプソメータ。

【請求項 7】 分光エリプソメータであって、

偏光した光を対象物へと導く照明部と、

前記対象物からの前記偏光した光の反射光を受光して前記反射光の波長毎の偏光状態を取得する受光部と、

を備え、

前記照明部が、

光源部と、

前記光源部からの光から前記偏光した光を得る偏光素子であるポーラライザと

、前記光源部から前記ポーラライザを経由して前記対象物に至る光路上に配置さ

れた複数の回転橜円体ミラーと、
を有することを特徴とする分光エリプソメータ。

【請求項 8】 分光エリプソメータであつて、
偏光した光を対象物へと導く照明部と、
前記対象物からの前記偏光した光の反射光を受光して前記反射光の波長毎の偏
光状態を取得する受光部と、
を備え、
前記照明部が、
光源部と、
前記光源部からの光から前記偏光した光を得る偏光素子であるポーラライザと
、
補助光を出射するもう 1 つの光源部と、
前記補助光を前記光源部からの光と重ね合わせる光学素子と、
前記もう 1 つの光源部から前記ポーラライザに至る光路上において、前記光源
部から前記対象物に至る光学系の開口絞り位置と光学的にほぼ共役な位置に配置
された遮光パターンと、
を有し、
前記受光部が、
前記反射光が入射する偏光素子であるアナライザと、
前記アナライザを経由した前記反射光が入射する分光器と、
前記反射光から前記補助光を取り出すもう 1 つの光学素子と、
前記遮光パターンと光学的に共役な位置に配置され、前記もう 1 つの光学素子
からの前記補助光を受光して前記遮光パターンの像を取得する撮像部と、
を有し、
前記照明部または前記受光部が、前記ポーラライザまたは前記アナライザを回
転する回転機構を有することを特徴とする分光エリプソメータ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、対象物に偏光した光を照射して対象物からの光の偏光状態を取得する分光エリプソメータに関する。

【0002】

【従来の技術】

従来より、半導体基板（以下、「基板」という。）上に形成される膜の厚さや光学定数等を測定するために、半導体装置の生産現場に分光エリプソメータが設置されて利用されている。分光エリプソメータでは偏光した光を基板上に照射してその反射光の波長毎の偏光状態を取得し、偏光解析することにより単層膜や多層膜に対する各種測定を行う。

【0003】

このような分光エリプソメータとして、特許文献1では、反射ミラーのみを用いてポーラライザからの偏光した光を基板へと導くとともに基板からの反射光をアナライザへと導くことにより、色収差の発生を抑制しつつ反射光の偏光状態を取得するものが開示されている。

【0004】

【特許文献1】

米国特許第5910842号明細書

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、近年、半導体装置の回路パターンの微細化・複雑化に伴い、基板上に形成される膜の厚さに精度が求められるため、分光エリプソメータによる測定の高精度化が求められている。同時に、生産現場の省スペース化を図るため、分光エリプソメータの小型化も要求されている。

【0006】

ところが、特許文献1の手法ではポーラライザとアナライザとの間の光路上にミラーが設けられるため、光の偏光状態が変化したり、ミラーの熱歪み等の影響により光の偏光状態が変動する恐れがあり、基板上に照射される光が反射する際の偏光状態の変化（すなわち、反射光の偏光状態）を精度よく取得することが困難である。ミラーへの光の入射角を小さくして偏光状態の変化を抑制する対策も

考えられるが、構造上の制約から分光エリプソメータが大型化してしまう。

【0007】

本発明は上記課題に鑑みなされたものであり、偏光解析に利用される情報を精度よく取得することを主たる目的とし、分光エリプソメータの小型化を図ることも目的としている。

【0008】

【課題を解決するための手段】

請求項1に記載の発明は、分光エリプソメータであって、偏光した光を対象物へと導く照明部と、前記対象物からの前記偏光した光の反射光を受光して前記反射光の波長毎の偏光状態を取得する受光部とを備え、前記照明部が、光源部と、前記光源部からの光から前記偏光した光を得る偏光素子であるポーラライザとを有し、前記光源部から前記対象物に至る光路上において、少なくとも1つの反射ミラーが前記光源部と前記ポーラライザとの間のみに配置される。

【0009】

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の分光エリプソメータであって、前記受光部が、前記反射光が入射する偏光素子であるアナライザと、前記アナライザを経由した前記反射光が入射する分光器とを有し、前記照明部または前記受光部が、前記ポーラライザまたは前記アナライザを回転する回転機構を有し、前記対象物から前記分光器に至る光路上において、少なくとも1つの反射ミラーが前記アナライザと前記分光器との間のみに配置される。

【0010】

請求項3に記載の発明は、請求項1または2に記載の分光エリプソメータであって、前記ポーラライザが、シート状の偏光素子である。

【0011】

請求項4に記載の発明は、請求項1ないし3のいずれかに記載の分光エリプソメータであって、前記光源部と前記ポーラライザとの間に複数の反射ミラーが配置される。

【0012】

請求項5に記載の発明は、請求項4に記載の分光エリプソメータであって、前

記複数の反射ミラーが、複数の回転楕円体ミラーを含む。

【0013】

請求項6に記載の発明は、分光エリプソメータであって、偏光した光を対象物へと導く照明部と、前記対象物からの前記偏光した光の反射光を受光して前記反射光の波長毎の偏光状態を取得する受光部とを備え、前記受光部が、前記反射光が入射する偏光素子であるアナライザと、前記アナライザを経由した前記反射光が入射する分光器とを有し、前記対象物から前記分光器に至る光路上において、少なくとも1つの反射ミラーが前記アナライザと前記分光器との間のみに配置される。

【0014】

請求項7に記載の発明は、分光エリプソメータであって、偏光した光を対象物へと導く照明部と、前記対象物からの前記偏光した光の反射光を受光して前記反射光の波長毎の偏光状態を取得する受光部とを備え、前記照明部が、光源部と、前記光源部からの光から前記偏光した光を得る偏光素子であるポーラライザと、前記光源部から前記ポーラライザを経由して前記対象物に至る光路上に配置された複数の回転楕円体ミラーとを有する。

【0015】

請求項8に記載の発明は、分光エリプソメータであって、偏光した光を対象物へと導く照明部と、前記対象物からの前記偏光した光の反射光を受光して前記反射光の波長毎の偏光状態を取得する受光部とを備え、前記照明部が、光源部と、前記光源部からの光から前記偏光した光を得る偏光素子であるポーラライザと、補助光を出射するもう1つの光源部と、前記補助光を前記光源部からの光と重ね合わせる光学素子と、前記もう1つの光源部から前記ポーラライザに至る光路上において、前記光源部から前記対象物に至る光学系の開口絞り位置と光学的にはほぼ共役な位置に配置された遮光パターンとを有し、前記受光部が、前記反射光が入射する偏光素子であるアナライザと、前記アナライザを経由した前記反射光が入射する分光器と、前記反射光から前記補助光を取り出すもう1つの光学素子と、前記遮光パターンと光学的に共役な位置に配置され、前記もう1つの光学素子からの前記補助光を受光して前記遮光パターンの像を取得する撮像部とを有し、

前記照明部または前記受光部が、前記ポーラライザまたは前記アナライザを回転する回転機構を有する。

【0016】

【発明の実施の形態】

図1は本発明の一の実施の形態に係る分光エリプソメータ1の構成を示す図である。分光エリプソメータ1は、薄膜（単層膜でも多層膜でもよい。）が形成された基板9が載置されるステージ2、ステージ2を図1中のX方向およびY方向に移動するステージ移動機構21、偏光した光（以下、「偏光光」という。）を基板9上へと導く照明部3、基板9からの偏光光の反射光を受光する受光部4、および、各種演算処理を行うCPUや各種情報を記憶するメモリ等により構成された制御部5を備える。

【0017】

照明部3は偏光解析用の光を出射する高輝度の測定用光源部31を有し、回転する偏光素子である（いわゆる、回転偏光子である）ポーラライザ32により測定用光源部31からの光から偏光光が得られて基板9上へと照射される。また、受光部4は基板9からの反射光が入射する偏光素子である（いわゆる、検光子である）アナライザ41を有し、アナライザ41を経由した反射光が分光器42へと入射して波長毎の偏光状態が取得される。

【0018】

ステージ移動機構21は、ステージ2を図1中のY方向に移動するY方向移動機構22、および、X方向に移動するX方向移動機構23を有する。Y方向移動機構22はモータ221にボールねじ（図示省略）が接続され、モータ221が回転することにより、X方向移動機構23がガイドレール222に沿って図1中のY方向に移動する。X方向移動機構23もY方向移動機構22と同様の構成となっており、モータ231が回転するとボールねじ（図示省略）によりステージ2がガイドレール232に沿ってX方向に移動する。

【0019】

制御部5は、各種演算を行う演算部51を有し、受光部4からの信号が演算部51へと入力される。また、照明部3およびステージ移動機構21も制御部5に

接続され、制御部5がこれらの構成を制御するとともに演算を実行することにより基板9上の膜に対する偏光解析に基づく各種測定結果が取得される。

【0020】

次に、照明部3および受光部4の詳細について説明する。測定用光源部31は高輝度キセノン(Xe)ランプを有する光源311およびレンズ群312を有し、光源311からの光がレンズ群312により板状のピンホールミラー331の裏面側に導かれる。なお、光源311は他の種類のランプ等により構成されてもよく、また、必要に応じて熱線カットフィルタや冷却ユニット等が設けられてもよい。

【0021】

ピンホールミラー331は、その反射面の法線がX軸に直交するとともに光軸J1に対して70度だけ傾斜する姿勢にて斜め上向きに固定されており、測定用光源部31からの光はピンホールミラー331の開口部（具体的には、X軸に平行な辺および垂直な辺の長さ150μmの正方形の開口部）を介して開口数（NA）0.02にて漸次広がりつつ非球面ミラー332へと導かれる。このとき、ピンホールミラー331から出射された直後の光の光軸J1に垂直な光束断面の形状は、X軸に平行な辺の長さが他の辺の長さよりも長い150μm×50μmの長方形とされる。

【0022】

非球面ミラー332は回転楕円体面の一部である反射面を有しており、凹面の非球面ミラー332に入射する光は凹面の非球面ミラー333へとさらに導かれる。非球面ミラー333も非球面ミラー332と同様に回転楕円体ミラーであり、非球面ミラー333にて反射された光は開口数0.1にて集光されつつポーラライザ32へと導かれる。

【0023】

ポーラライザ32は、例えば、石英ガラスにPVC（ポリ塩化ビニル）膜等を塗布して2色性膜を形成したシート状の偏光素子であり、ステッピングモータ321の内側に位置する中空の回転体内に固定される（すなわち、中空タイプのステッピングモータ321の中空部に配置される。）。ステッピングモータ321

は制御部5の制御により光軸J1に平行な軸を中心として回転し、これにより、ステッピングモータ321の回転角に応じた偏光光がポーラライザ32から導き出されて70度の入射角にて基板9上に照射される。

【0024】

照明部3では、ピンホールミラー331から基板9に至る光学系は、5対1の縮小光学系となっているため、基板9の表面近傍における偏光光の光軸J1に垂直な光束断面の形状は、X軸に平行な辺の長さが $30\mu\text{m}$ であり、他の辺の長さが $10\mu\text{m}$ である長方形となる。したがって、基板9上における偏光光の照射領域はおよそ $30\mu\text{m} \times 30\mu\text{m}$ の正方形の微小領域となる。

【0025】

以上のように、照明部3では測定用光源部31とポーラライザ32との間の光路上にのみ配置される2枚の非球面ミラー332、333により、測定用光源部31からピンホールミラー331を介して出射される光よりも大きな開口数にて光が集光されつつポーラライザ32へと導かれ、ポーラライザ32からの偏光光が比較的高い光量にて基板9上の微小領域に照射される。その際、ポーラライザ32がシート状であって厚さが薄いため、ポーラライザ32において生じる色収差が許容範囲に抑えられる。

【0026】

基板9からの反射光は、スリット板431により取り込まれてアナライザ41へと導かれる。スリット板431の開口部は、X軸に平行な辺の長さが他の辺の長さよりも十分に長い長方形とされ、X軸に垂直な方向（ほぼ高さに相当する方向）に関して開口数が0.05とされる。これにより、取り込まれる反射光の基板9上の反射角の範囲が制限される。一方、X方向に関しては反射光はほとんど制限されないため、測定に必要な十分な量の光がアナライザ41へと導かれる。

【0027】

アナライザ41としては、高精度に安定して光を偏光するロションプリズムが使用され（ポーラライザ32と同様にシート状の偏光素子であってもよい。）、アナライザ41を透過した光は球面ミラー432を介してコールドミラー433にて反射され、スリット板434の開口部を介して分光器42にて受光される。

分光器 42 は、好ましくは、ペルチェ素子等により冷却される裏面照射型の 1 次元 CCD を有するツエルニーターナー型分光器であり、入射する光が高い波長分解能にて分光され、波長毎（例えば、紫外線から近赤外線までの波長毎）の光の強度が高感度に測定される。そして、反射光の波長毎の強度がポーラライザ 32 の回転角に対応付けられることにより、波長毎の反射光の偏光状態、すなわち、波長毎の p 偏光成分と s 偏光成分との位相差および反射振幅比角が取得される。

【0028】

基板 9 から分光器 42 に至る光学系は 1 対 1 の等倍光学系となっており、スリット板 434 の開口部の断面形状が $200 \mu m$ 角の正方形となっている。したがって、分光器 42 では基板 9 上において偏光光の照射領域よりも十分に広い $200 \mu m \times 600 \mu m$ の矩形領域からの光が受光可能とされ、アナライザ 41 にて色収差が生じたとしても分光器 42 にて取得される反射光の偏光状態に大きな影響は生じない。

【0029】

照明部 3 には、さらに、追加的な照明光（本実施の形態では赤外光が使用され、以下、「補助光」という。）を出射する発光ダイオードを有する補助光源部 34 が設けられ、補助光源部 34 からの補助光はコンデンサレンズ 341 を介してパターンプレート 35 へと導かれる。パターンプレート 35 には所定の遮光パターン（例えば、十字の標線）が形成されており、補助光は遮光パターンに対応する部分が遮られつつピンホールミラー 331 へと導かれる。なお、補助光源部 34 は測定用の光と波長が異なる光を生成するのであれば必ずしも発光ダイオードを有するものである必要はなく、例えば、ランプにより補助光が生成されてもよい。

【0030】

ピンホールミラー 331 の反射面上には、後述するフォーカス調整に利用されるフォーカス調整用パターン（例えば、開口部から離れた位置に形成された格子状の標線）が形成されており、照射される補助光が測定用光源部 31 からの光に重ね合わされて非球面ミラー 332 に向けて反射され、非球面ミラー 333 およびポーラライザ 32 を介して基板 9 上における偏光光の照射位置と同じ照射位置

へと導かれる。

【0031】

このとき、ピンホールミラー331の位置と基板9上の照射位置とが光学的に共役とされるため（換言すると、ピンホールミラー331の位置が測定用光源部31から基板9に至る光学系の視野絞り位置に該当するため）、基板9上には偏光光の照射領域の外側においてフォーカス調整用パターンの像が形成される。これに対し、パターンプレート35は測定用光源部31から基板9に至る光学系の開口絞り位置と光学的にほぼ共役な位置に配置されており、基板9上の補助光の照射領域には遮光パターンの影響は現れない。

【0032】

基板9からの反射光は、スリット板431、アナライザ41および球面ミラー432を介してコールドミラー433へと導かれ、コールドミラー433において反射光のうち補助光（すなわち、赤外光）のみが透過されて取り出される。透過した補助光はミラー435にて反射され、ハーフミラー436に導かれる。ハーフミラー436では補助光の一部が反射され、遮光パターン撮像部44にて受光される。遮光パターン撮像部44の位置は、パターンプレート35から基板9の表面を経由して遮光パターン撮像部44に至る光学系においてパターンプレート35と光学的に共役とされるため、遮光パターン撮像部44には遮光パターンの像が結像される。遮光パターン撮像部44からは遮光パターンの画像データが制御部5へと出力される。

【0033】

補助光のうちハーフミラー436を透過したものはレンズ437を介して基板撮像部438へと導かれて受光される。基板撮像部438の位置はピンホールミラー331および基板9の表面の位置と光学的に共役とされ、基板撮像部438により基板9上のフォーカス調整用パターンの像が取得される。分光エリプソメータ1では、取得された基板9上のパターンの画像のコントラストに基づいて制御部5がステージ2に設けられたステージ昇降機構24を昇降し、基板9の表面が一定の高さにされる（すなわち、フォーカス調整が行われる）。

【0034】

分光エリプソメータ1により測定が行われる際には、受光部4により反射光の偏光状態が取得されるのと同時に、基板9が水平面（すなわち、図1中のXY平面）に対して傾斜する傾斜角の測定も行われる。具体的には、測定用光源部31および補助光源部34それぞれからの光の出射が開始され、分光器42により偏光光の反射光の波長毎の偏光状態が取得されつつ遮光パターン撮像部44により遮光パターンの画像が取得される。

【0035】

このとき、前述のように補助光の照射位置における基板9の表面の高さが一定に保たれるとともに、遮光パターン撮像部44の位置がパターンプレート35に対して基板9の表面を経由して光学的に共役となる位置とされるため、遮光パターン撮像部44にて取得される画像中の遮光パターンの位置は、基板9の傾斜角（正確には、補助光の照射位置における傾斜角）に対応した位置となる。したがって、演算部51により取得された画像中の遮光パターンの重心位置と予め記憶された傾斜角が0度のときの画像中の遮光パターンの重心位置との間の距離（ベクトル）が算出されることにより、基板9の傾斜角（例えば、基板9の法線方向を示すベクトル）が求められる。

【0036】

基板9の傾斜角と反射光の偏光状態とが取得されると、演算部51では、傾斜角（および、傾斜方向）から求められる正確な入射角を用いつつ取得された偏光状態に基づいて基板9上の膜に対して偏光解析が行われ、膜の光学定数や厚さ等の測定結果が取得される。

【0037】

以上に説明したように、図1の分光エリプソメータ1では、測定用光源部31から基板9の表面を経由して分光器42に至る光路上において、反射ミラーがポーラライザ32とアナライザ41との間には設けられず、測定用光源部31とポーラライザ32との間、および、アナライザ41と分光器42との間のそれぞれにのみ配置される。これにより、ポーラライザ32からの偏光光をそのままの偏光状態で基板9の表面へと照射するとともに、偏光光の反射光を偏光状態を変化させることなくアナライザ41へと導くことができる。その結果、分光エリプソ

メータ 1 では反射による偏光光の偏光状態の変化および偏光光の反射光の偏光状態を精度よくかつ安定して取得することができ、基板 9 上の膜に対する偏光解析を高精度に行うことができる。

【0038】

また、測定用光源部 3 1 とポーラライザ 3 2 との間に複数の反射ミラー（特に、2つの非球面ミラー 3 3 2, 3 3 3）が配置されることにより、光路を複数回折り曲げて照明部 3 をコンパクトにすることも実現される。さらに、分光エリプソメータ 1 では、基板 9 の傾斜角を測定するために用いられる光学系（すなわち、補助光源部 3 4 から基板 9 の表面を経由して遮光パターン撮像部 4 4 へと至る光学系）の一部と、偏光状態を取得するために用いられる光学系の一部（すなわち、測定用光源部 3 1 から基板 9 の表面を経由して分光器 4 2 へと至る光学系）とが共有されるため、分光エリプソメータ 1 の小型化を図ることができる。なお、測定用光源部 3 1 とポーラライザ 3 2 との間に複数の反射ミラーには、折り返しミラー等の他の種類のミラーが適宜含められてもよい。

【0039】

以上、本発明の実施の形態について説明してきたが、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、様々な変形が可能である。

【0040】

上記実施の形態では、ポーラライザ 3 2 にステッピングモータ 3 2 1 が取り付けられるが、アナライザ 4 1 にステッピングモータが設けられてもよい。この場合、受光部 4 にて取得される反射光の波長毎の偏光状態は、アナライザ 4 1 の回転角に対応付けて取得される。また、ポーラライザ 3 2 またはアナライザ 4 1 には他の手法による回転機構が設けられてもよい。

【0041】

上記実施の形態では、測定用光源部 3 1 から基板 9 の表面を経由して分光器 4 2 に至る光路上において、ポーラライザ 3 2 とアナライザ 4 1 との間に反射ミラーが配置されないが、分光エリプソメータの要求される測定精度や設計上の都合等によってはポーラライザ 3 2 と基板 9 との間、および、基板 9 とアナライザ 4 1 と間のいずれか一方のみに反射ミラーが配置されてもよい。特に、分光エリプ

ソメータの小型化のみを目的とする場合、複数の回転橜円体ミラー（3以上であってもよい。）は測定用光源部31からポーラライザ32を経由して基板9に至る光路上のいずれの位置に配置されてもよい。

【0042】

パターンプレート35は必ずしも補助光源部34とピンホールミラー331との間に配置される必要はなく、補助光源部34からポーラライザ32に至る光路上において、測定用光源部31から基板9に至る光学系の開口絞り位置と光学的にはほぼ共役な位置であればいずれの位置に配置されてもよい。

【0043】

補助光を測定用光源部31からの光と重ね合わせる光学素子は、ピンホールミラー331以外であってもよく、例えば、ハーフミラーでもよい。同様に、反射光から補助光を取り出す光学素子もコールドミラー433とは異なるものであってもよい。

【0044】

基板9は、半導体基板に限定されず、例えば、液晶表示装置やその他のフラットパネル表示装置等に使用されるガラス基板であってもよい。さらに、分光エリプソメータ1による測定対象は、微細パターンが形成される基板以外の物に形成された膜であってもよい。

【0045】

【発明の効果】

請求項1ないし5の発明では、対象物にポーラライザからの偏光した光をそのままの偏光状態で照射することができ、測定精度を高めることができる。

【0046】

また、請求項2および6の発明では、対象物からの反射光を偏光状態を変化させることなくアライザへと導くことができ、測定精度を高めることができる。

【0047】

また、請求項3の発明では色収差の影響を抑制することができる。

【0048】

また、請求項4、5および7の発明では、分光エリプソメータの小型化を図る

ことができる。

【0049】

請求項8の発明では、対象物の傾斜角を求めることができるとともに分光エリプソメータの小型化を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

分光エリプソメータの構成を示す図である。

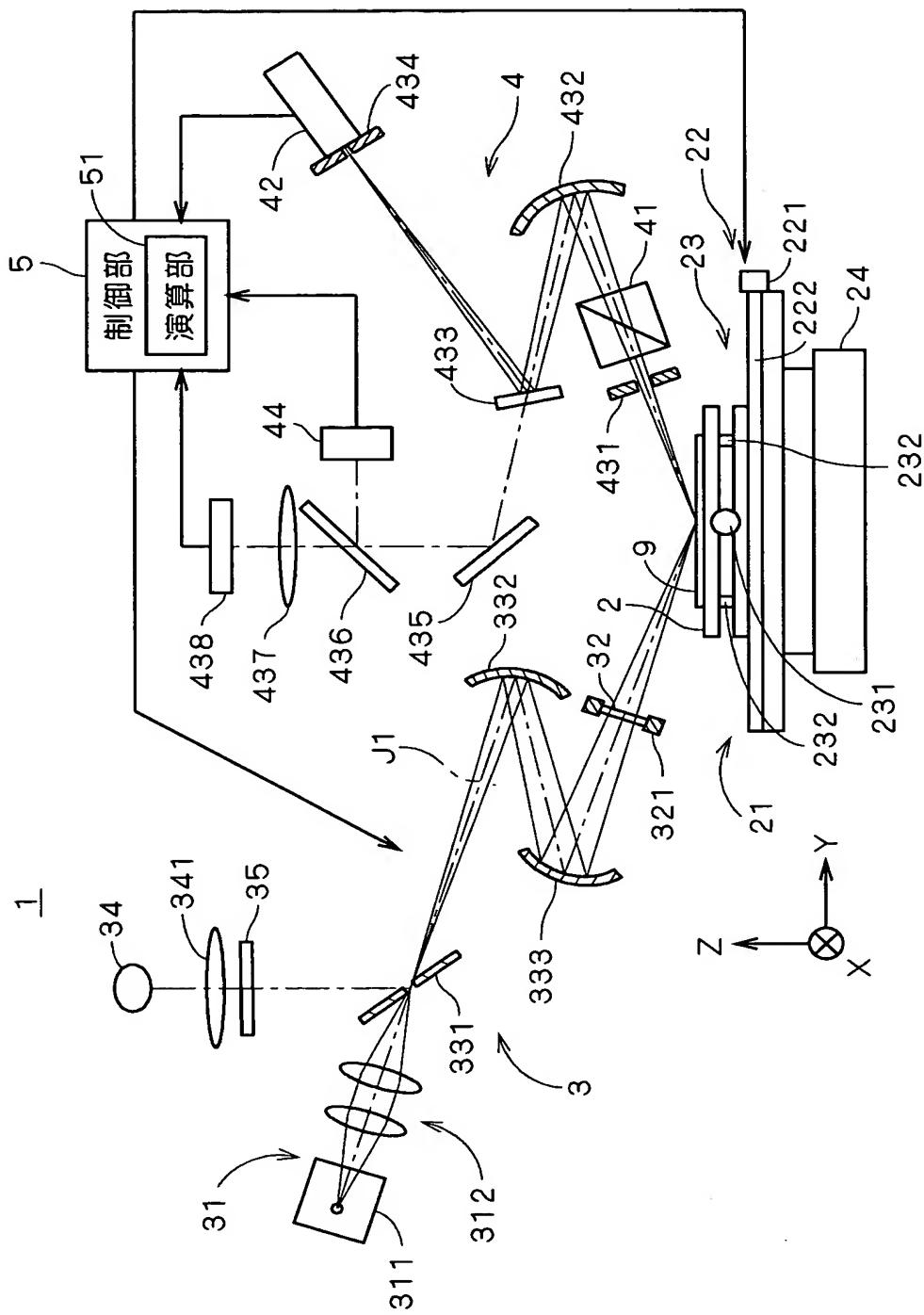
【符号の説明】

- 1 分光エリプソメータ
- 3 照明部
- 4 受光部
- 9 基板
- 3 1 測定用光源部
- 3 2 ポーラライザ
- 3 4 補助光源部
- 3 5 パターンプレート
- 4 1 アナライザ
- 4 2 分光器
- 4 4 遮光パターン撮像部
- 3 2 1 ステッピングモータ
- 3 3 1 ピンホールミラー
- 3 3 2, 3 3 3 非球面ミラー
- 4 3 2 球面ミラー
- 4 3 3 コールドミラー

【書類名】

図面

【図 1】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 測定精度の高い分光エリプソメータを提供する。

【解決手段】 分光エリプソメータ 1 の照明部 3 は測定用光源部 3 1 を有し、ポーラライザ 3 2 により測定用光源部 3 1 からの光から偏光光が得られて基板 9 上へと導かれる。また、受光部 4 は基板 9 からの偏光光の反射光が入射するアナライザ 4 1 を有し、アナライザ 4 1 を経由した反射光が分光器 4 2 へと入射して波長毎の偏光状態が取得される。分光エリプソメータ 1 では、測定用光源部 3 1 とポーラライザ 3 2 との間、および、アナライザ 4 1 と分光器 4 2 との間のそれぞれにのみミラーが配置される。これにより、分光エリプソメータ 1 ではミラーにより偏光光やその反射光の偏光状態が変化せず、精度の高い測定が実現される。

【選択図】 図 1

特願2003-141796

出願人履歴情報

識別番号 [000207551]

1. 変更年月日 1990年 8月15日
[変更理由] 新規登録
住 所 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の
1
氏 名 大日本スクリーン製造株式会社